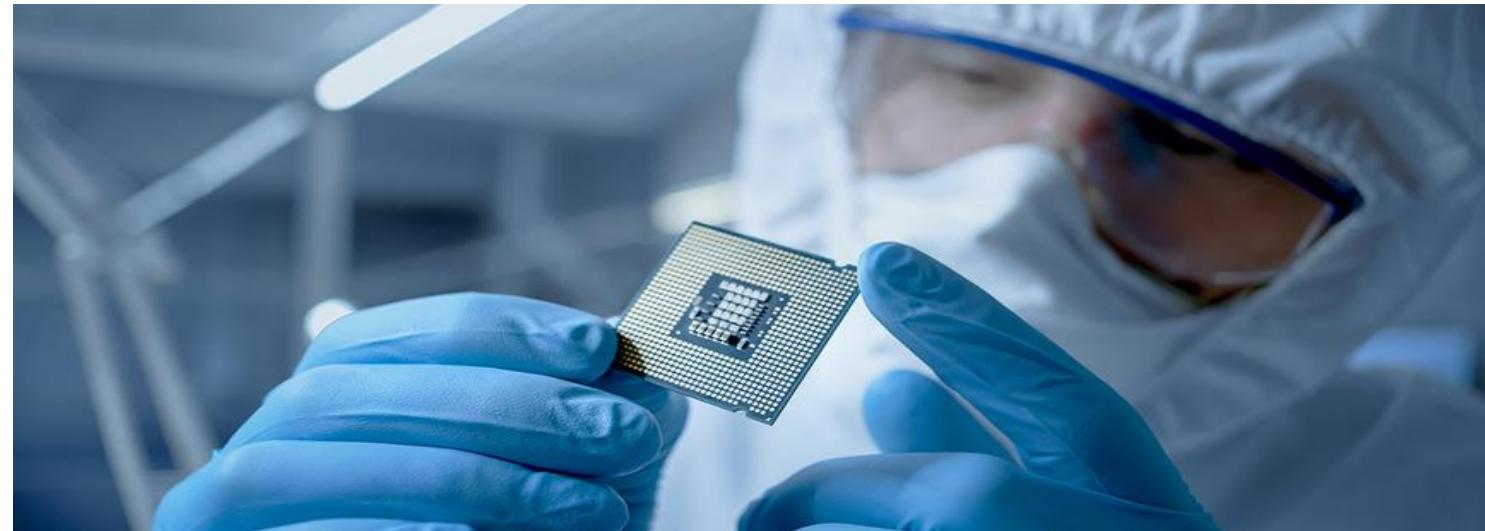


VM (주)

Investor Relations

11.2025



Disclaimer

본 자료는 기관투자자 및 일반투자자를 대상으로, VM 주식회사(이하 "회사")의 사업 및 재무 등 경영상황에 대한 이해를 돋기 위한 목적으로 작성된 것으로, 회사의 홍보 또는 주식·증권의 매수·매도를 권유하기 위한 자료가 아닙니다.

본 자료에 포함된 회사의 경영실적 및 재무성과 관련 정보는 일반적으로 인정된 기업회계기준에 따라 작성된 것입니다. 또한 본 자료에는 회사의 향후 경영현황 및 재무실적과 관련된 "예측정보"가 포함되어 있을 수 있습니다. 예측정보란 과거가 아닌 미래의 사건 및 전망과 관련된 정보를 의미하며, '예상', '전망', '계획', '기대', '(E)' 등의 표현을 포함합니다. 이러한 예측정보는 개별적인 검증 절차를 거치지 않은 것으로, 거시경제 여건·산업 환경·경영전략의 변경 등 다양한 변수에 따라 실제 결과는 예측정보와 중대한 차이가 발생할 수 있습니다. 또한, 모든 전망은 작성일 현재 이용 가능한 정보와 시장상황, 회사의 경영방향을 기준으로 한 것이며, 향후 환경 변화 및 회사의 판단에 따라 별도의 고지 없이 변경될 수 있습니다.

본 자료는 투자 판단을 위한 참고자료일 뿐이며, 어떠한 경우에도 회사의 주식 또는 기타 유가증권의 모집, 매출, 매매 및 청약을 위한 법적·사실상의 제안이나 권유를 구성하지 않습니다. 또한 본 자료의 그 어느 부분도 관련 계약 체결이나 투자 결정을 위한 기초 또는 근거로 사용될 수 없습니다.

본 자료의 이용 또는 이에 기초한 투자행위로부터 직·간접적으로 발생하는 어떠한 손실에 대하여도 회사 및 회사의 이사, 임직원은 과실 유무를 불문하고 그 책임을 부담하지 않습니다. 모든 투자 결정은 투자자 본인의 책임과 판단에 따라 이루어져야 합니다.

본 자료는 투자자에 대한 정보 제공을 위한 비영리적·내부적 참고용으로만 사용될 수 있으며, 회사의 사전 서면 동의 없이 본 자료의 전부 또는 일부를 임의로 수정·가공하거나 복사·배포·전재하는 행위는 금지됩니다.

CONTENTS

VM Investor Relations 2025

01 회사소개

04 Our Strategy

02 Our Business

Appendix

03 PEER 비교

회사 개요

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| 회사명 | 브이엠 주식회사(VM, Inc) |
| 대표자 | 최우형 / 임종필 |
| 설립일 | 2002-02-22 |
| 본사 소재지 | 경기도 이천시 마장면 서이천로 58-47 |
| 임직원 / 특허 수 ^(*) | 108명 / 72개 (해외 28개 포함) |
| 매출액 / 영업이익 ^(*) | 936억 / 153억 |

(*) 2025년 9월말 현재

대표이사 약력

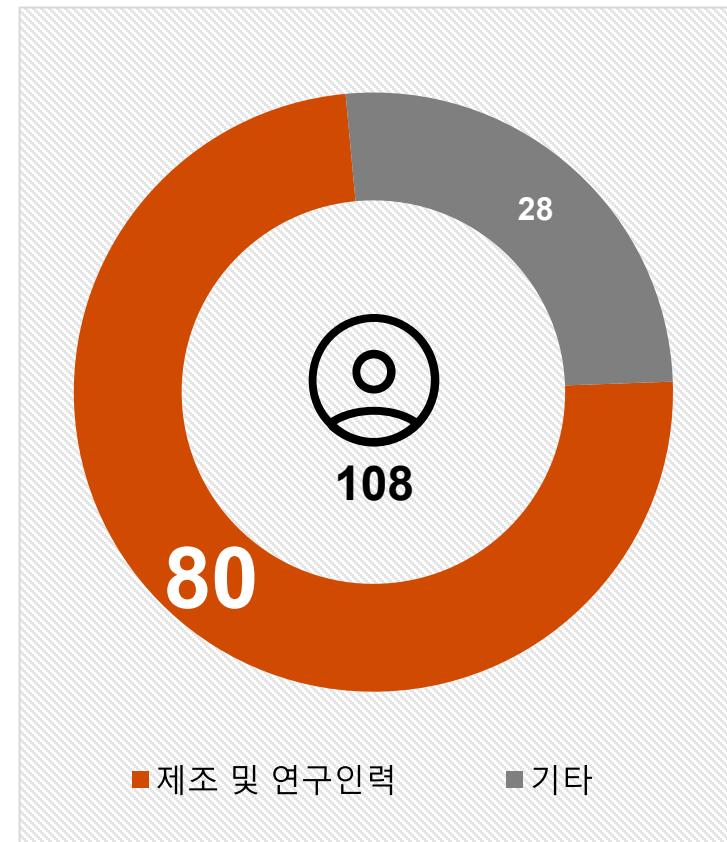
최우형

- 現 VM(주) 대표이사 ('18.11 ~)
- KoFc-KB 청년창업펀드 매니저
- KB인베스트먼트 투자담당 이사
- 고려대학교 경영학과

임종필

- 現 VM(주) 대표이사 ('24.04 ~)
- Essencore Co. 대표이사, 사장
- SK SUPEX추구협의회,
공유 Infra T/F팀장
- SK하이닉스 구매본부장

핵심 인력 구성 비율

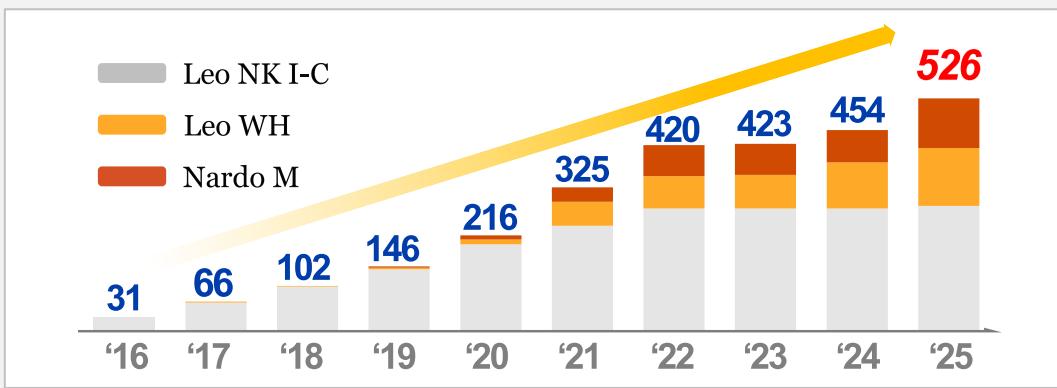


(*) 2025년 11월말 현재



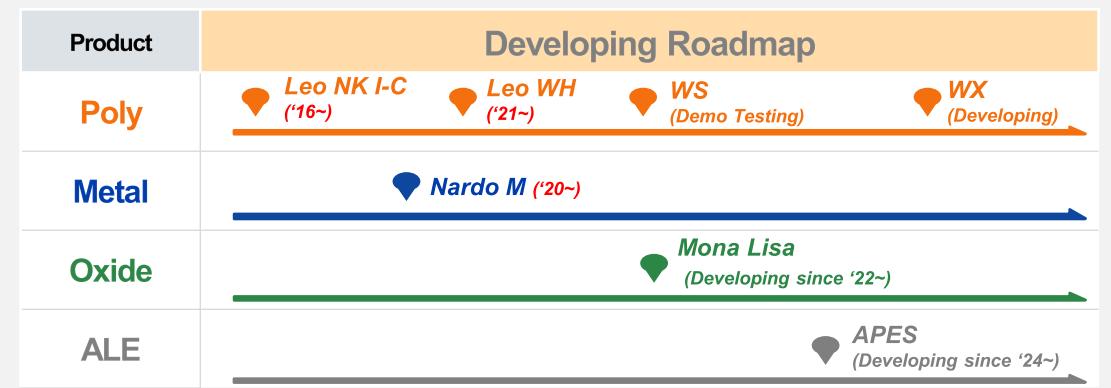
누적 챔버 공급 현황

누적 500EA 이상 챔버 판매 기록 중



납품 장비 및 개발 로드맵

Poly & Metal 양산 판매 중 (**Oxide & ALE** 개발 중)



주요 실적 및 전망

최근 3개년 재무현황

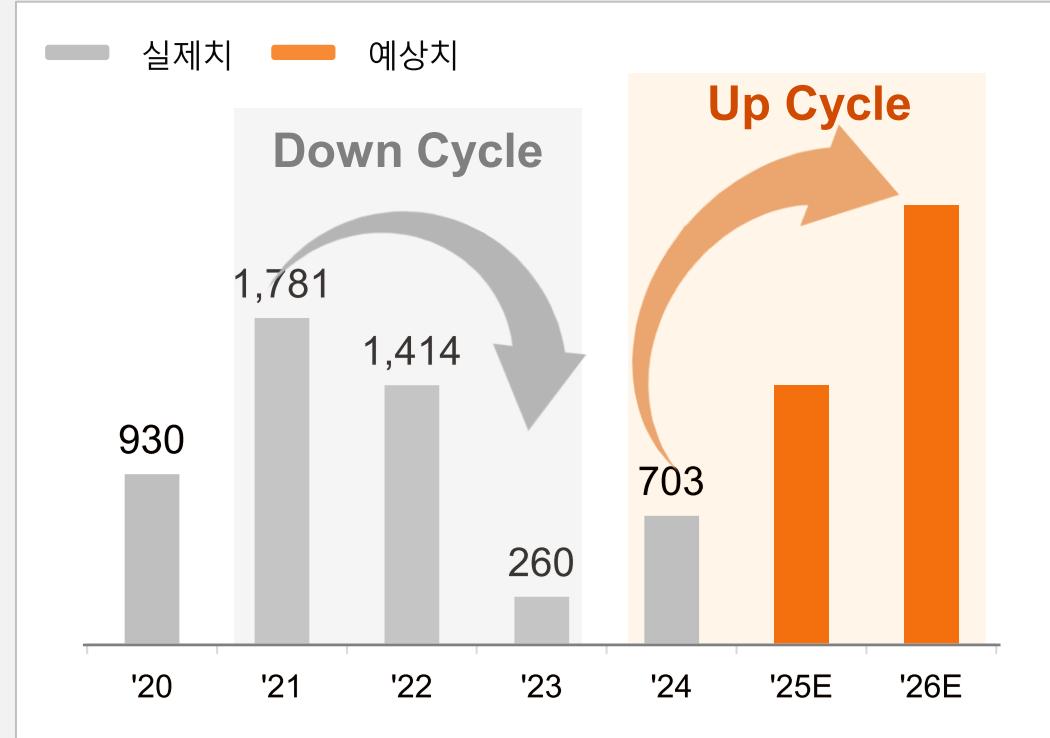
(단위: 억원)

| 구분 | '21.12 | '22.12 | '23.12 | '24.12 | '25.09 |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 순자산총계 | 1,141 | 1,179 | 1,222 | 1,243 | 1,614 |
| 매출액 | 1,781 | 1,414 | 260 | 703 | 936 |
| -제품 | 1,650 | 1,198 | 98 | 548 | 695 |
| -상품 | 131 | 216 | 162 | 155 | 241 |
| 영업이익(손실) | 540 | 309 | (110) | (86) | 153 |
| 당기순이익(손실) | 465 | 279 | (70) | (35) | 150 |

연결 재무제표 기준

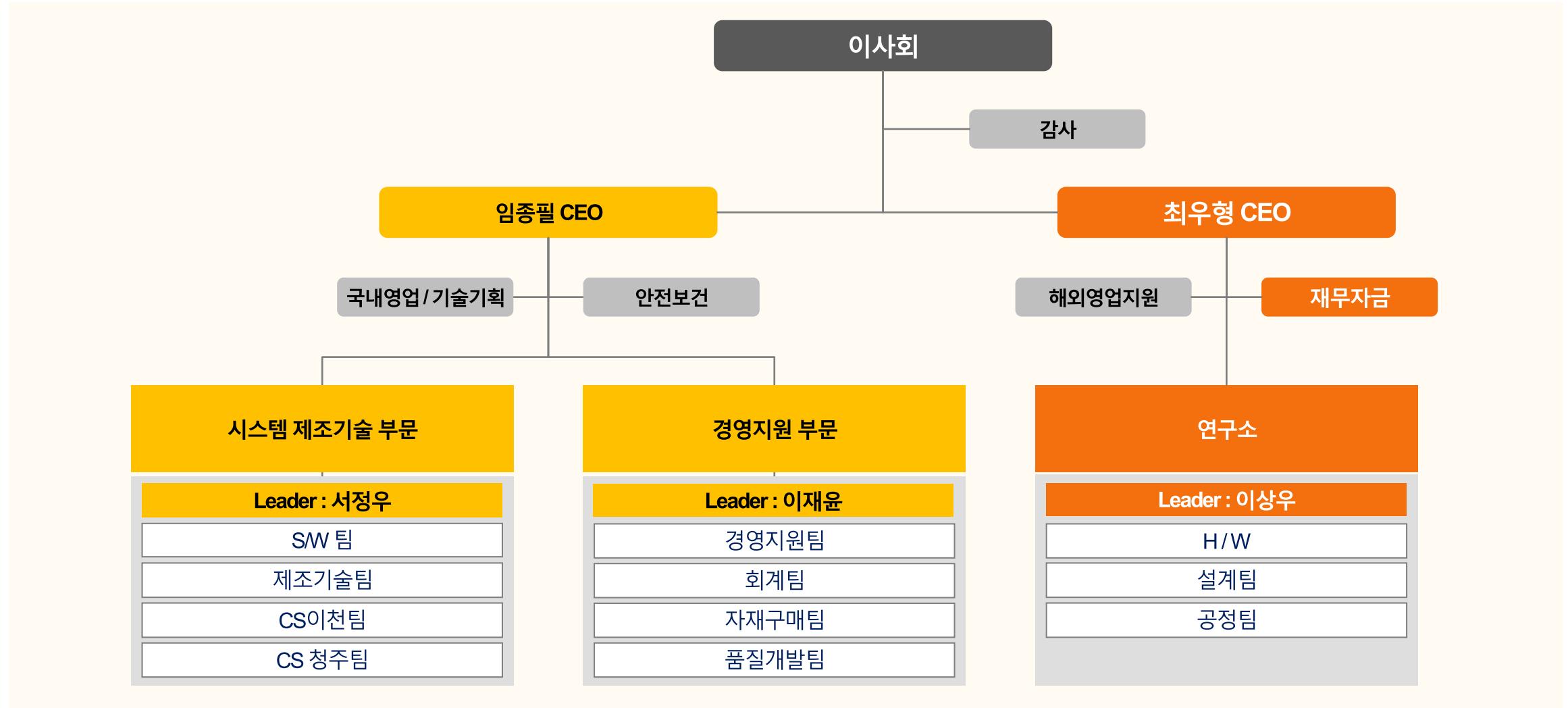
매출 성장 추이

(단위: 억원)



연결 재무제표 기준

주요 조직 현황



CONTENTS

VM Investor Relations 2025

01 회사 소개

02 Our Business

03 Our Strength

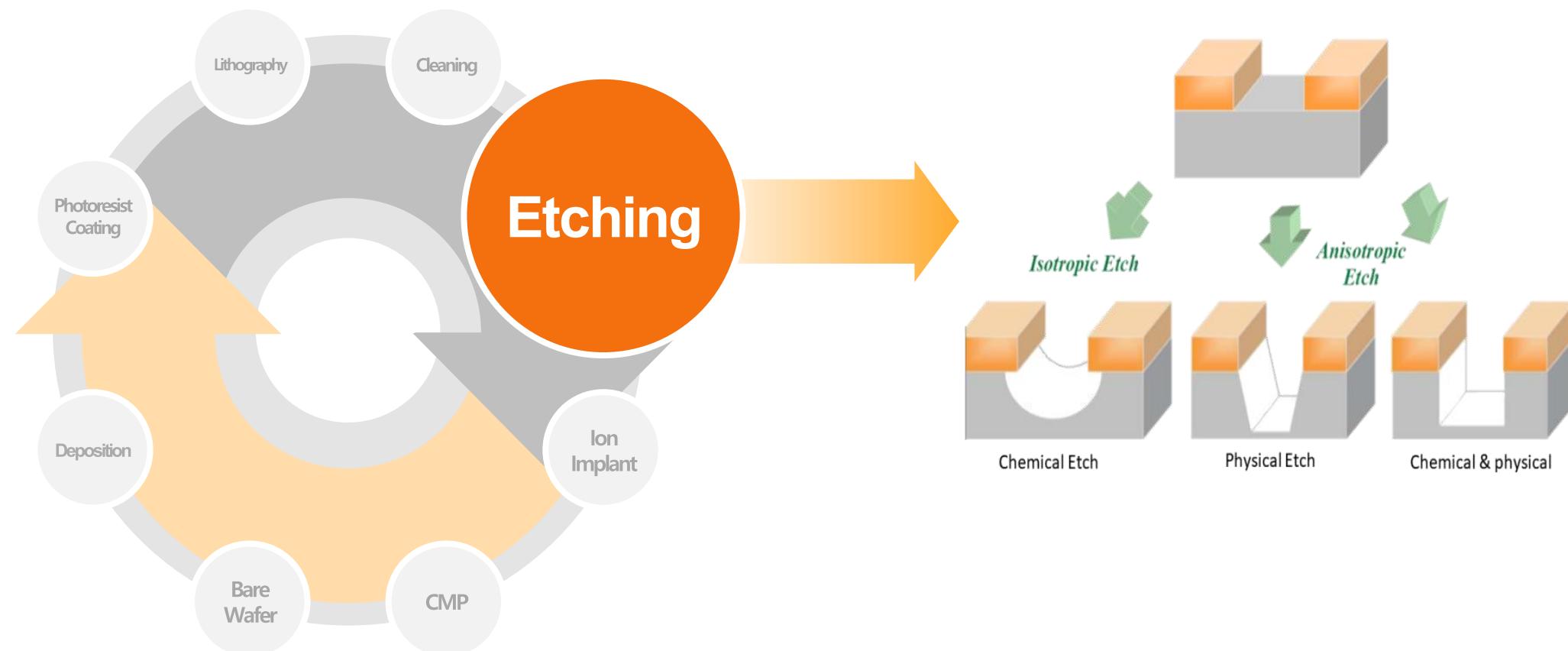
04 Our Strategy

Appendix

식각 (Etching) 공정이란?

노광 공정 이후 진행되는 핵심 전공정 단계로, 웨이퍼에 새겨진 회로 패턴을 따라 필요 없는 **박막 부분을 깎아내어** 회로를 실제로 형성하는 공정

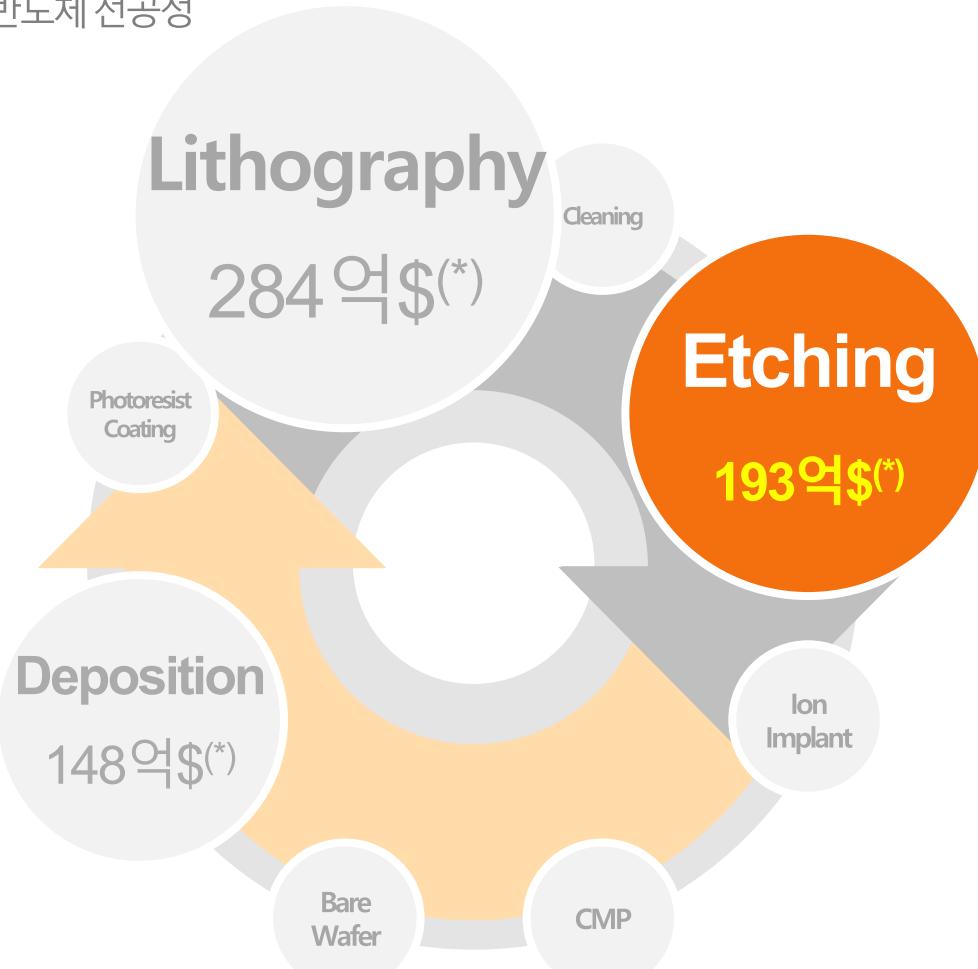
※반도체 전공정



식각 (Etching) 공정이란?

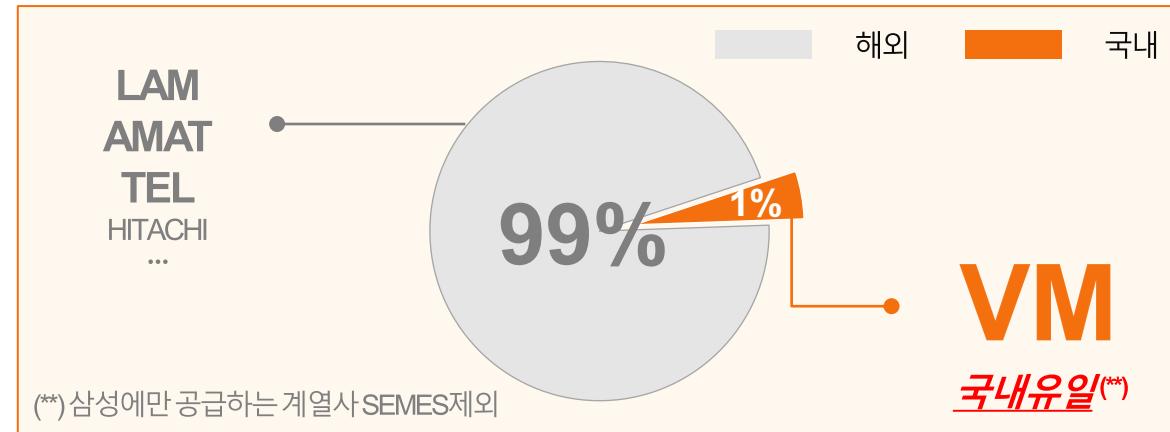
노광&증착공정과 함께 **반도체의 3대 핵심 공정** (총 8공정) 중의 한 공정이며, **국내**의 글로벌 식각장비 기술 업체는 **VM**이 **유일**

※반도체 전공정

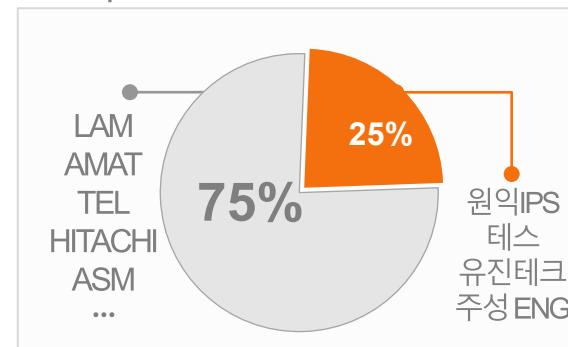


(*) Gartner 2025년 시장규모 연간 추정치 (첨부 워크시트 참조)

※ Etching 장비 글로벌 시장점유율



※ Deposition



※ Lithography_(EUV ARF 기준)



Gartner WFE Capacity_3Q25

| 구 분 | Model | Status | Device | Process | Features | |
|----------------------|---|--------------|--------------|---------|---|---|
| Conductor ETCHER |  | Leo NK I-C | 양산 | DRAM | Non-critical Etch | High Productivity /High Process Reliability |
| | | | | NAND | | Low Defectivity Advantage for Total Cost Ownership |
| | | Leo WH | 양산 | DRAM | Middle & High Critical Etch | High Productivity /High Process Reliability |
| | | | | NAND | | Enhance yield of wafer-edge dies High Operation Rate |
| | | Leo WS | DEMO TEST | DRAM | High Critical Etch | H/W High Performance |
| | | | | NAND | | Process High Reliability Repeatability Wafer Productivity Quality Up |
| Dielectric ETCHER |  | Nardo M | 양산 | DRAM | Critical / Non-critical Metal Etch | High Productivity /High Process Reliability |
| | | | | NAND | | Low Defectivity Advantage for Total Cost Ownership |
| OXIDE ETCHER |  | Mona LISA | Developing | DRAM | Non-critical Oxide Etch | High Productivity /High Process Reliability |
| | | | | NAND | | Low Defectivity Advantage for Total Cost Ownership |
| ALE |  | APES A | Developing | DRAM | High Critical Etch Complex-geometry Etch | High Productivity /High Process Reliability |
| | | | | NAND | | High Selectivity Hybrid Etch (Thermal/Plasma) |

CONTENTS

VM Investor Relations 2025

01 회사소개

02 Our Business

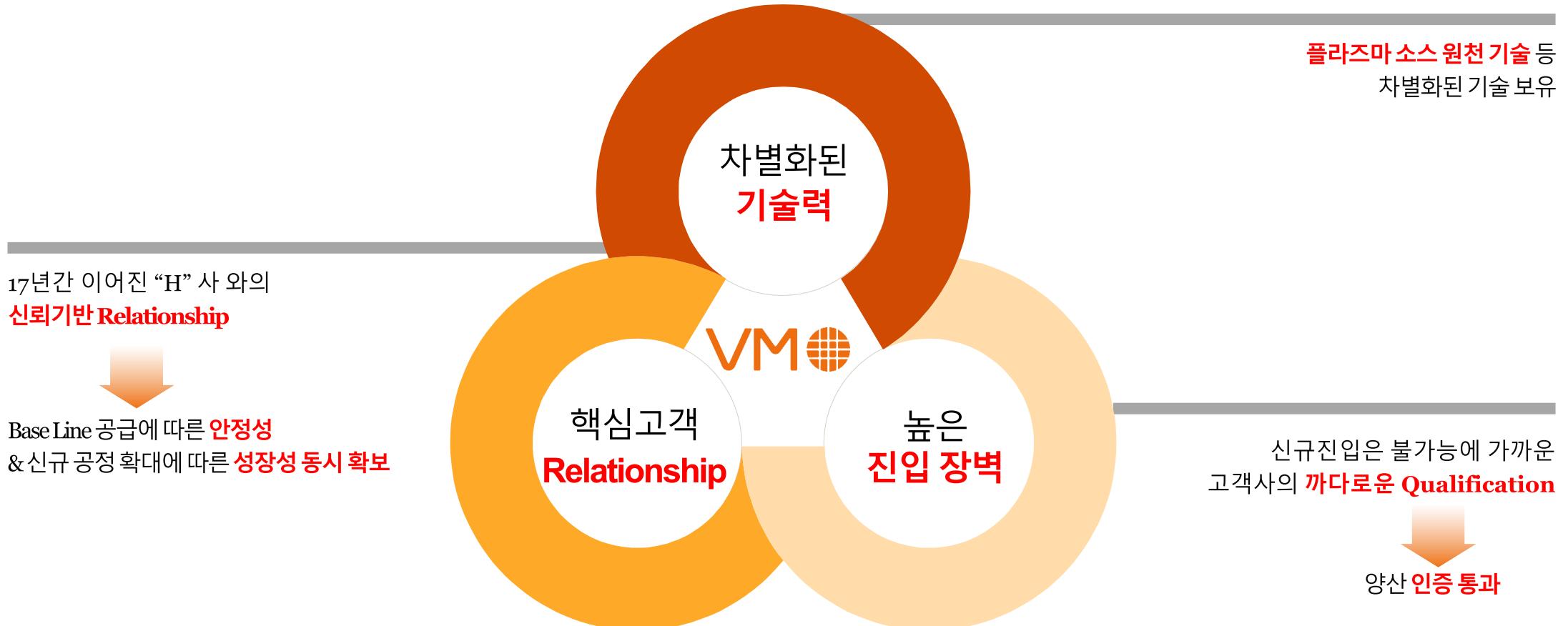
03 Our Strength

04 Our Status

05 Our Strategy

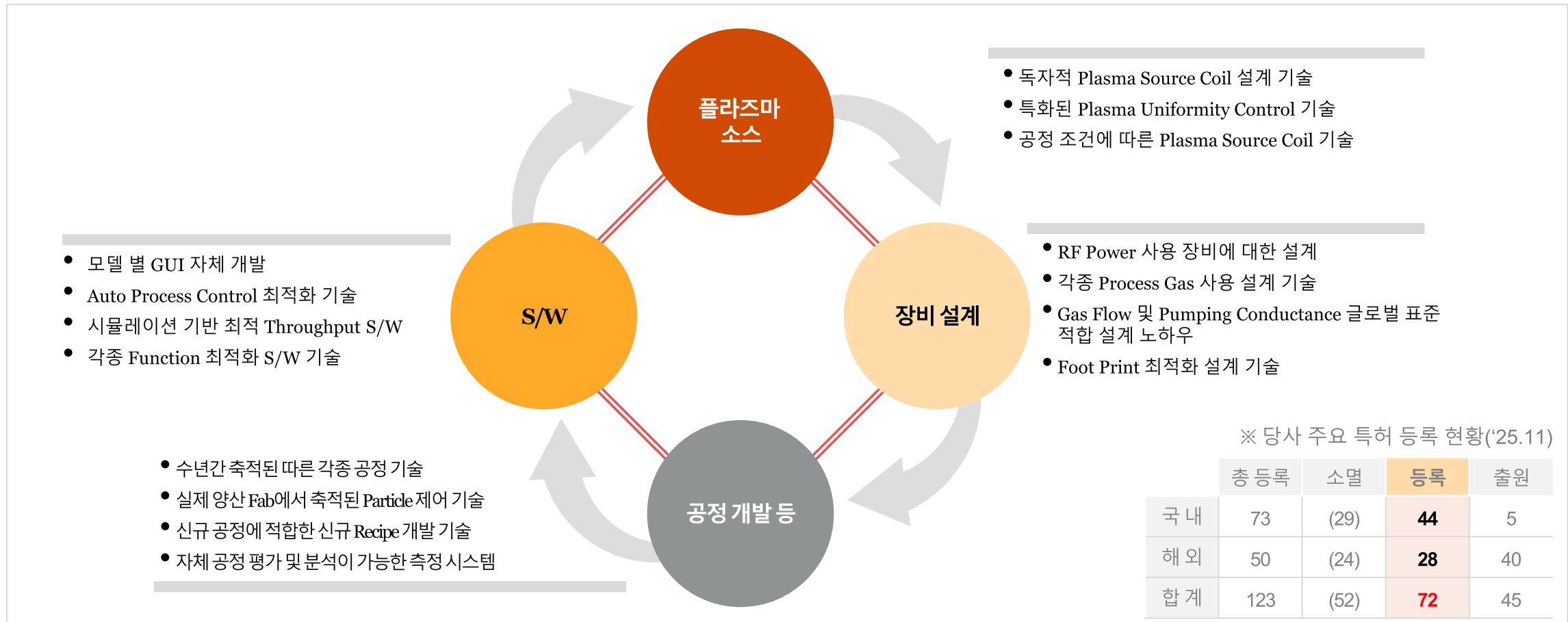
Appendix

총괄



차별화된 기술력

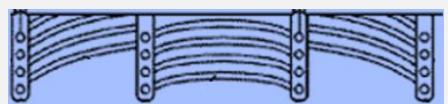
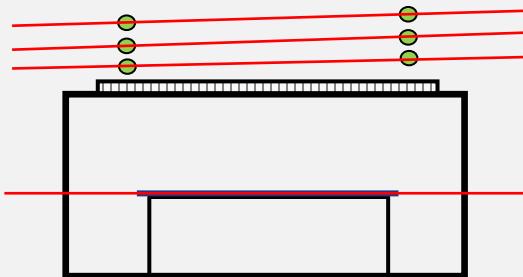
차별화된 **플라즈마 소스 원천 기술**을 통한 **글로벌 기술경쟁력** 보유



차별화된 기술력

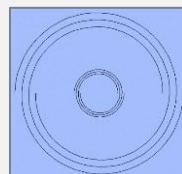
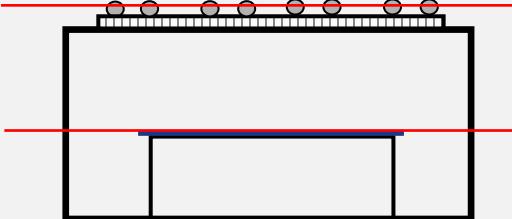
※ VM's 플라즈마 코일 vs 타사

A사



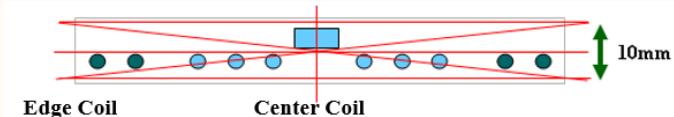
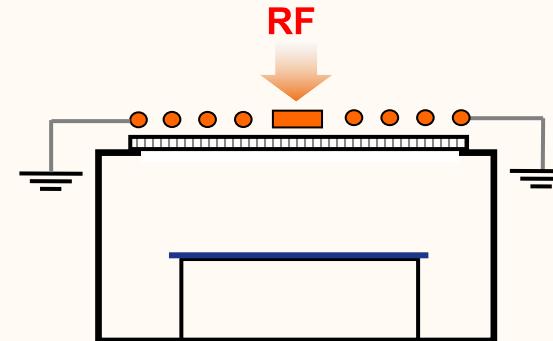
다수의 Coil Plane & 사선 구조라
Tilting Control이 직관적이지 못함
 효과가 없거나 미미할 것 예상됨

L사



Dome과 Coil이 붙어 있음
Tilting Mechanism 구현 불가

VM

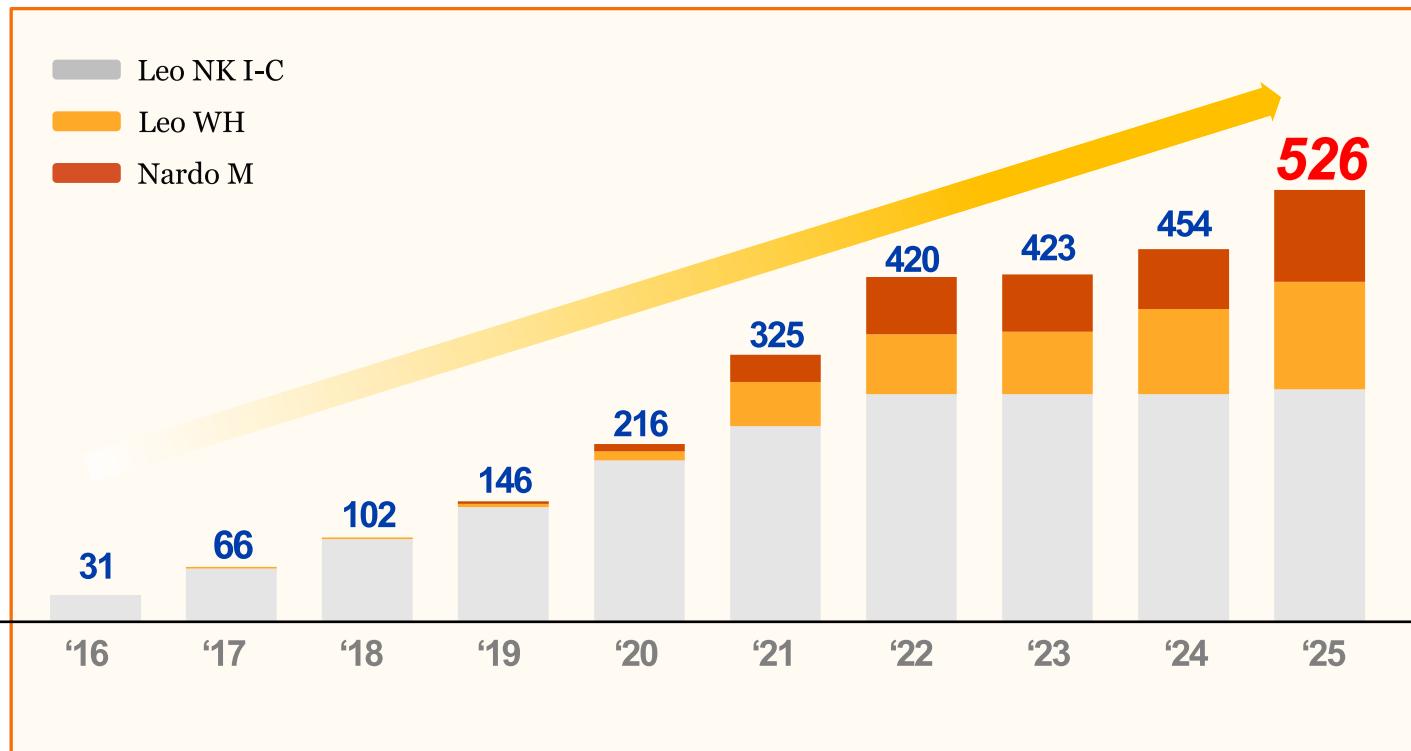


나선형 Symmetry 구조 병렬 합성 Coil
 Dome 사이 공간을 통해 **Tilting Mechanism 구현**
뚜렷한 Tilting 효과 및 직관적 Control 가능

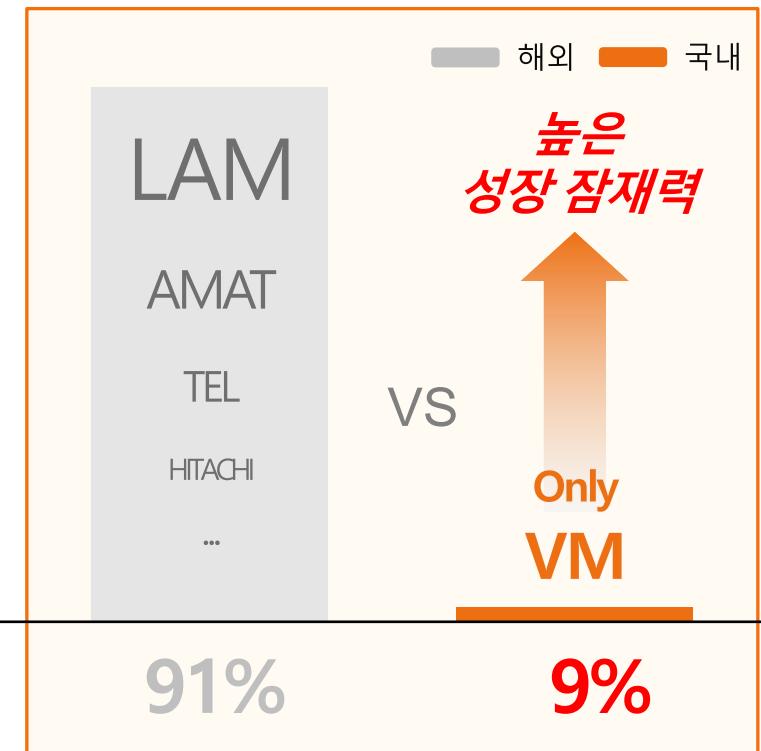
핵심고객 Relationship

신뢰기반 Relationship에 따른 **Base Line 공급 안정성** & 공정 점유율 확대에 따른 **높은 성장성** 동시 보유

※ “H” 사 누적 챔버 판매량



※ “H” 사 식각공정 점유율

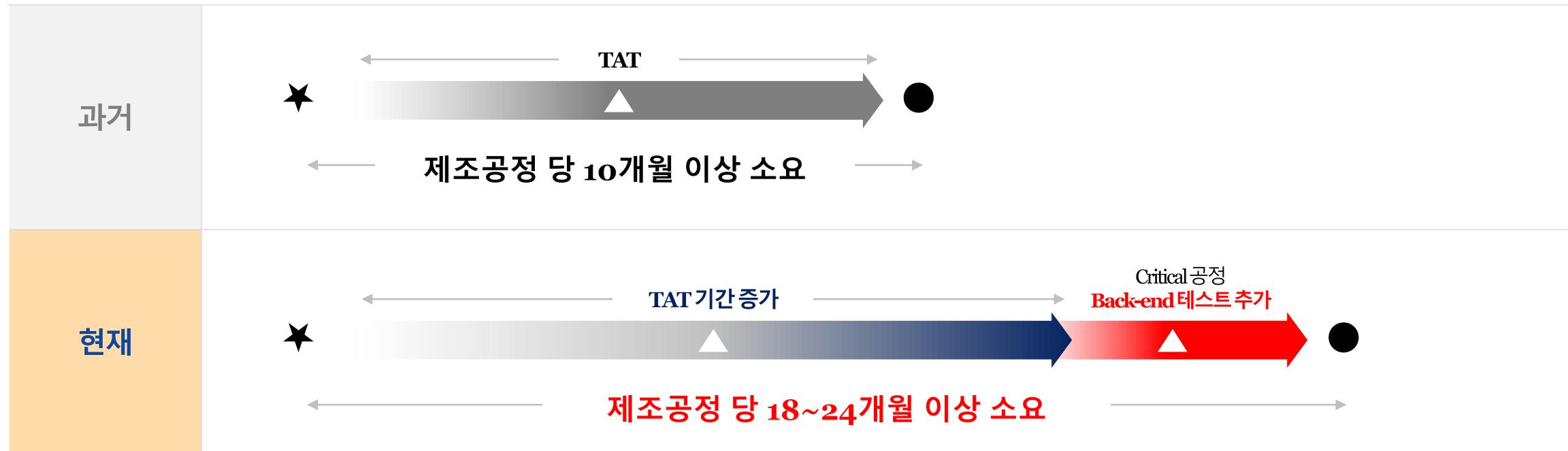


높은 진입장벽

공정의 미세화 ▶ 점점 더 까다로운 Qualification ▶ 기존 검증 업체 외 신규업체 진입 거의 불가

※ “H”사 Qualification 공정 TEST Process (예시)

★ 공정착수 ▲ 퀄테스트 ● TEST완료



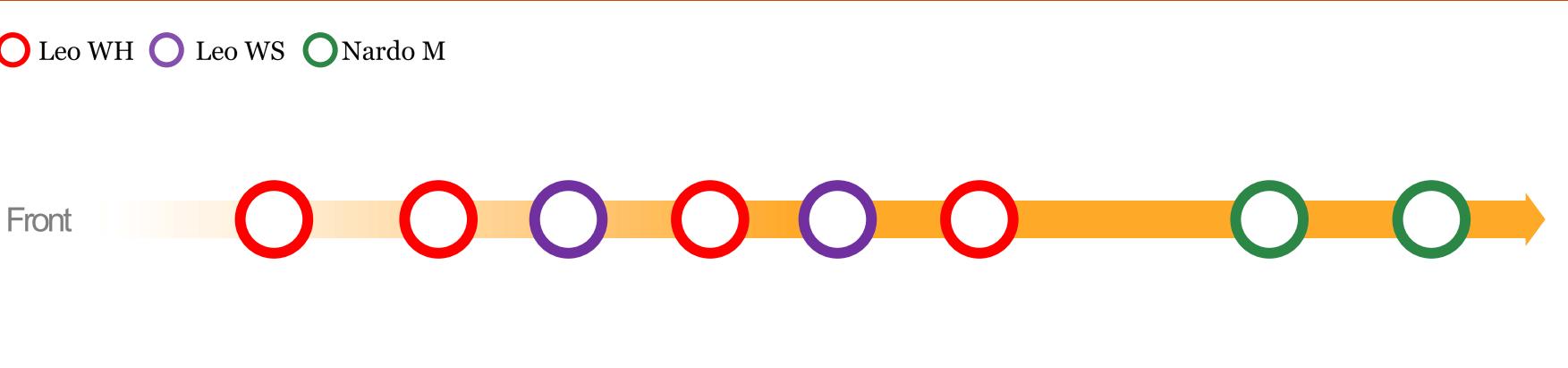
(*) TAT : Turn Around Time, 웨이퍼가 모든 공정을 거쳐 최종적으로 반도체 칩이 되어 공장을 빠져나오는 데까지 걸리는 총 소요 시간

(*) **Back-end Test:** 완성된 반도체 칩이 정상적으로 작동하는지, 그리고 제품의 기능과 성능이 규격에 맞는지 여부에 대한 최종 검증.

높은 진입장벽

고객사의 까다로운 **Qualification** 통과 성공 & **차세대** 제품에 대한 **테스트 진행** 중

※주요 고객사 양산장비 투입 및 테스트 현황

| Requirement | Our Position |
|--|--|
| <p>“H”</p> <p>○ Leo WH ○ Leo WS ○ Nardo M</p> <p>Front</p>  | <ul style="list-style-type: none">타 공급사 대비 기술적 역량 & 비용 경쟁력 모두 충족필요한 기능만을 반영한 Customized 장비 요구 <ul style="list-style-type: none">다수 공정에서 Qualification 통과 & Base 장비 선정차세대 제품 Customized 평가 진행 중 |

CONTENTS

VM Investor Relations 2025

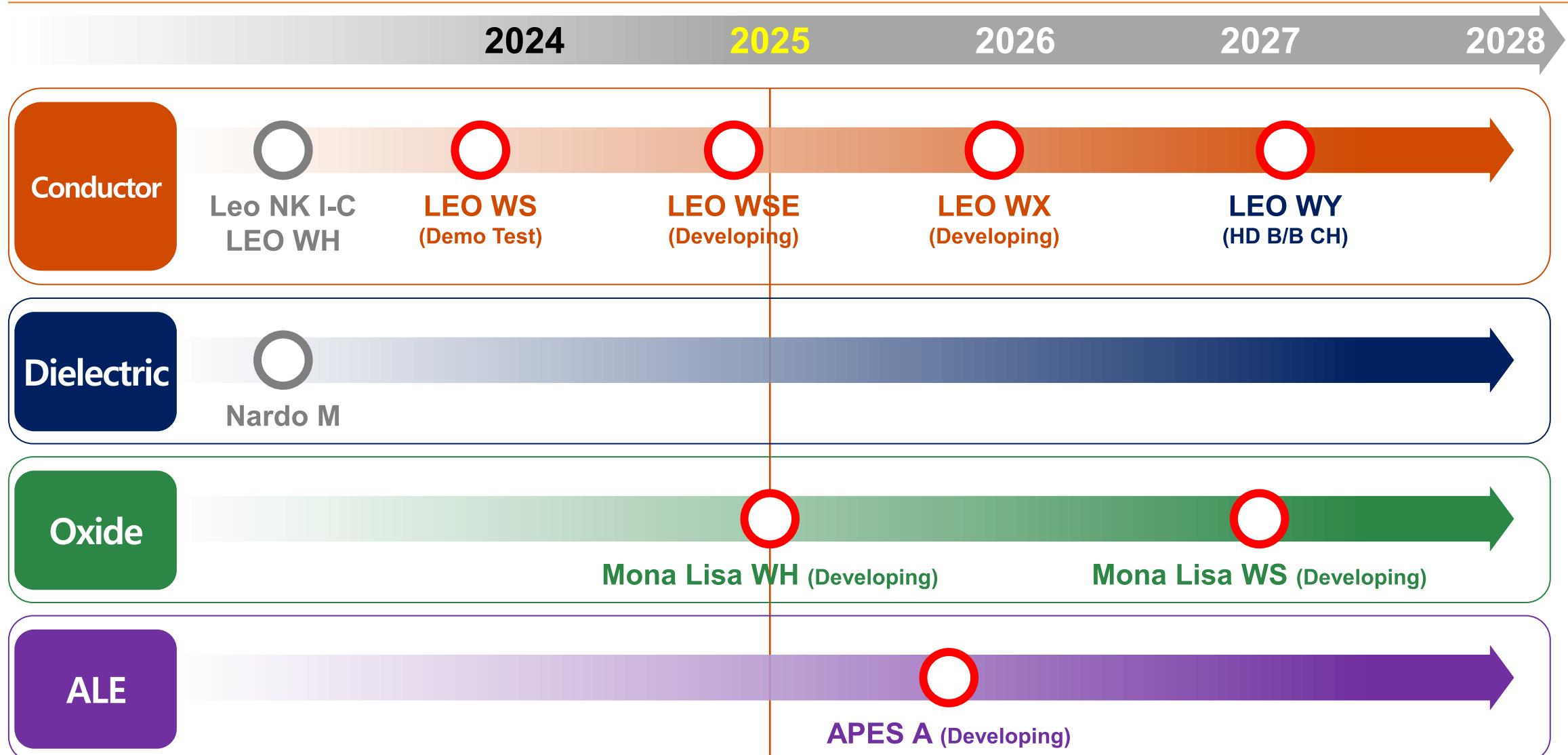
01 회사소개

02 Our Business

03 Our Strength

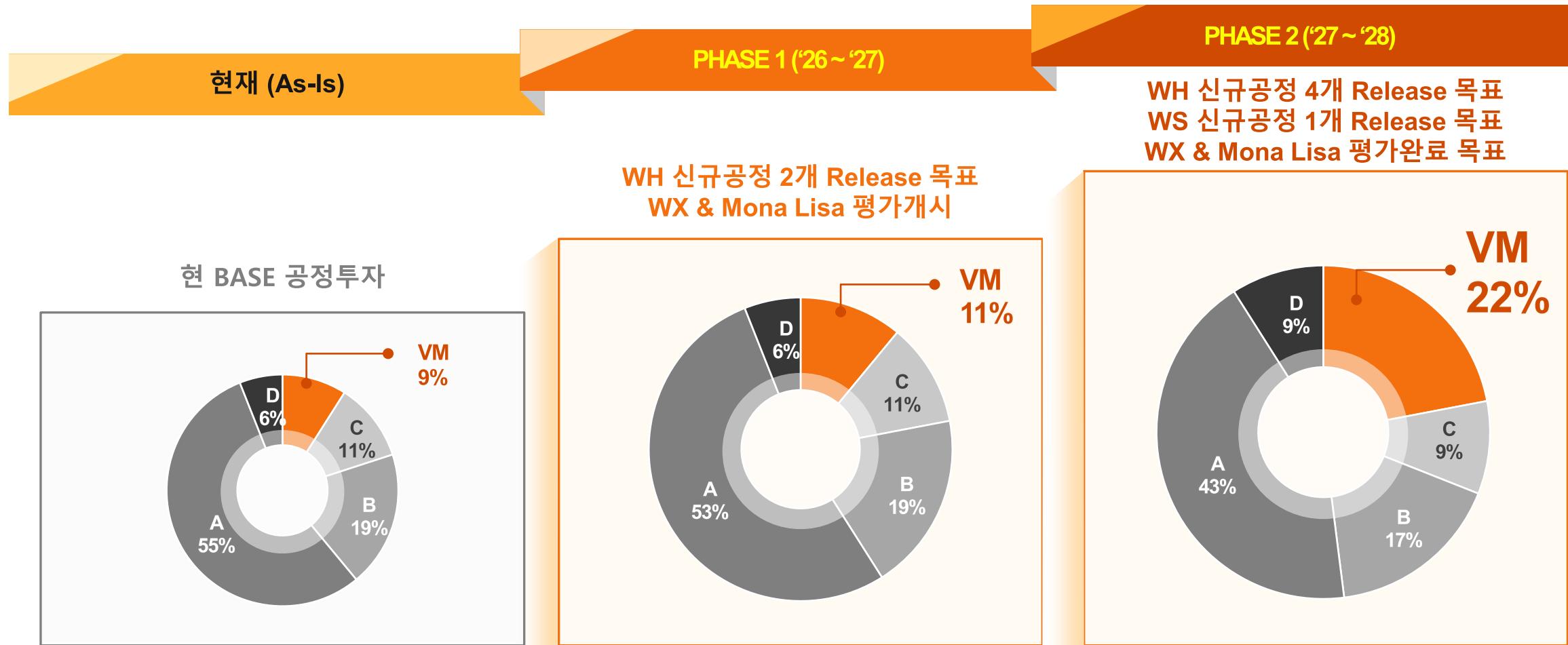
04 Our Strategy

Appendix



공정확대 목표

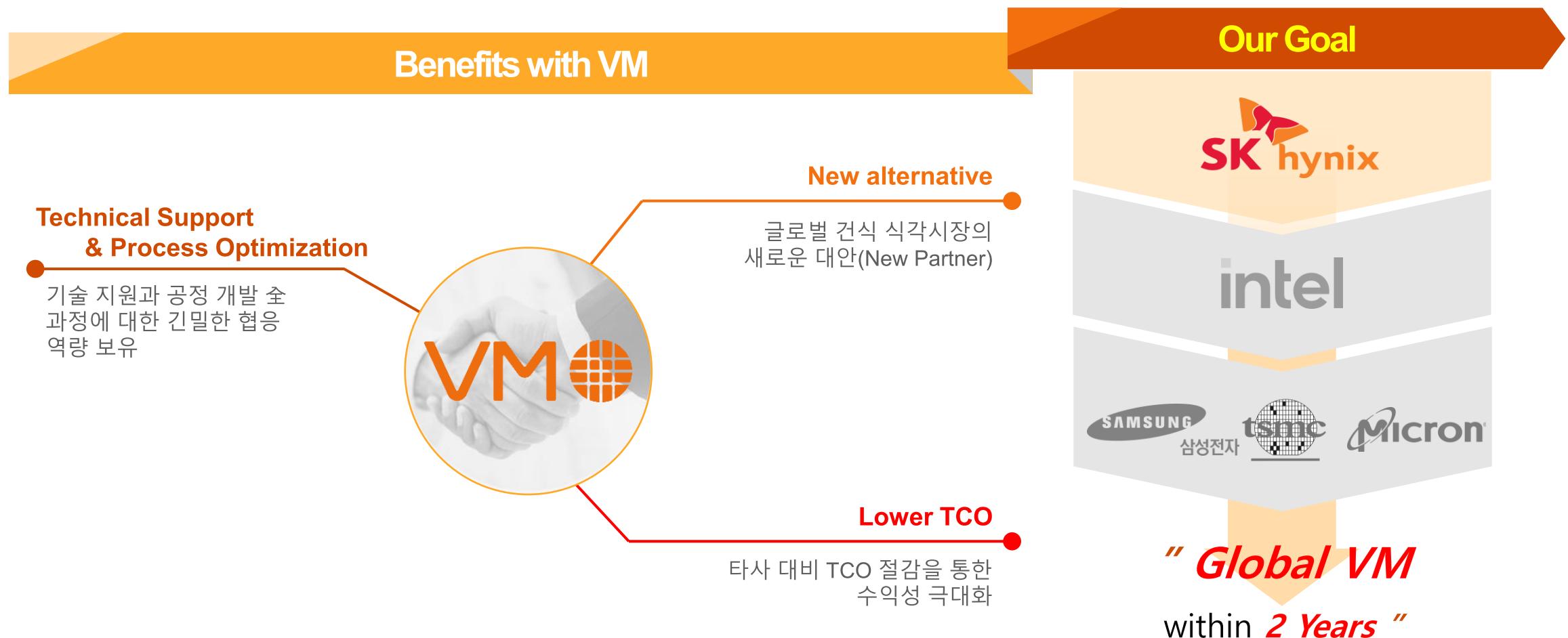
신규공정 BASE 전환을 통한 공정 점유율 확대 계획



글로벌 진출 Roadmap

“I” 사 Qualification 통과 및 이를 기반으로 한 해외 진출 적극 모색





■ 용인 반도체 클러스터 본사이전 조감도



소재지

용인 원삼면
반도체 클러스터

규모

토지 2,580평
건폐율 80%(2,064평)
용적률 350%(7,224평)

소요 예산

약 700억 전후

준공시기

‘28년 초 (예상)

CONTENTS

VM Investor Relations 2025

01 회사소개

02 Our Business

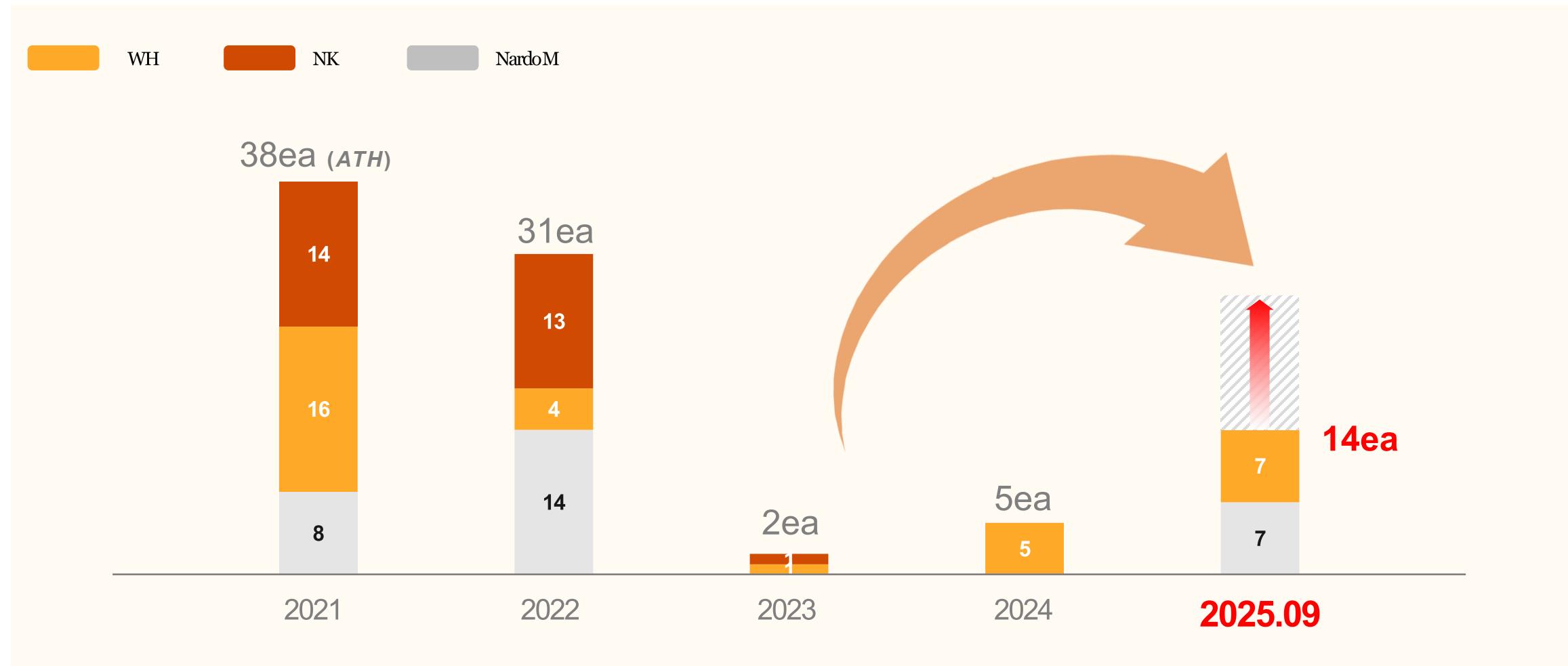
03 Our Strength

04 Our Strategy

- Appendix

제품 별 판매량

빠른 실적회복 & 26년 ATH(All Time High) 간신 전망



요약 재무제표

요약 재무상태표

(단위 : 억원, 연결재무제표)

| 구 분 | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025.09 |
|--------|-------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 자산 | 유동자산 | 1,337 | 1,451 | 1,407 | 1,505 | 1,938 |
| | 비유동자산 | 119 | 115 | 102 | 152 | 190 |
| 부채 | 유동부채 | 283 | 373 | 270 | 393 | 485 |
| | 비유동부채 | 32 | 14 | 18 | 21 | 29 |
| 자본 | 자본금 등 | 204 | 179 | 291 | 349 | 570 |
| | 이익잉여금 | 937 | 1,000 | 930 | 894 | 1,044 |
| 부채자본비율 | | 28% | 33% | 24% | 33% | 32% |

요약 손익계산서

(단위 : 억원, 연결재무제표)

| 구 분 | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025.09 |
|-------|--|--------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| 매출액 | | 1,781 | 1,414 | 260 | 703 | 936 |
| 매출총이익 | | 774 | 595 | 127 | 234 | 352 |
| 영업이익 | | 540 | 309 | (110) | (86) | 153 |
| 당기순이익 | | 465 | 279 | (70) | (35) | 150 |
| 영업이익률 | | 30.3% | 21.9% | (42.2%) | (12.2%) | 16.4% |

(단위 : 억원, 연결재무제표)



VM 특허 현황_국내

| | 명칭 | 등록 |
|----|--------------------------------|------------|
| 1 | 고온 기체 공급형 공정 시스템 | 10-2826840 |
| 2 | 플라즈마 컨파이닝을 위한 플라자마 처리 장치 | 10-2797766 |
| 3 | 기판 손상 감소 구조의 원자층 식각 장치 | 10-2691602 |
| 4 | 플라즈마 챔버의 상부 전극 체결용 수직 파스너 어셈블리 | 10-2689279 |
| 5 | 이종 소재 부품의 접착에 의한 모듈화 방법 | 10-2662900 |
| 6 | 상부 전극의 경사 및 위치 조절 시스템 | 10-2662977 |
| 7 | 분사 노즐 구조의 웨이퍼 잔존 가스 제거 장치 | 10-2634530 |
| 8 | 셀로우 에칭 프로세스 챔버 | 10-2626118 |
| 9 | 멀티 층 EFEM을 포함하는 기판 이송장치 | 10-2638655 |
| 10 | 층 이동이 가능한 기판 이송 장치 | 10-2638654 |

| | 명칭 | 등록 |
|----|-------------------------------|------------|
| 11 | 상하부 자기 부상 레일을 이용하는 기판 이송 장치 | 10-2041518 |
| 12 | 기판 이송장치 | 10-2090278 |
| 13 | 기판 이송장치 | 10-2027110 |
| 14 | 플라즈마 에칭 시스템 | 10-1839578 |
| 15 | 압력 측정 오차 방지를 위한 입자 트랩 장치 | 10-2005843 |
| 16 | 다중 가열 영역 구조의 정전 척 | 10-1776848 |
| 17 | 부품 정렬 장치 및 이에 의한 부품 정렬 방법 | 10-1787500 |
| 18 | 플라즈마 소스 코일 및 이의 조정 방법 | 10-1748252 |
| 19 | 플라즈마 소스 코일 어셈블리 및 이에 의한 가열 방법 | 10-1614410 |
| 20 | 분리형 플라즈마 소스 코일 및 이의 제어 방법 | 10-1585945 |

| 명칭 | | 등록 |
|----|------------------------------------|------------|
| 21 | 교환 장치 및 이에 의한 부품의 교환 방법 | 10-2090278 |
| 22 | 히터 패턴을 내장한 웨이퍼 척 및 제조 방법 | 10-2027110 |
| 23 | 복수의 가스공급채널을 갖는 반도체 제조설비 | 10-1839578 |
| 24 | 분리형 웨이퍼 서셉터 및 반도체 공정 챔버 장비 | 10-2005843 |
| 25 | 원자층 식각장비 및 이를 이용한 원자층 식각 방법 | 10-1776848 |
| 26 | 반도체 제조설비 및 반도체 웨이퍼 처리 방법 | 10-1787500 |
| 27 | 리프트핀을 갖는 반도체 제조설비 및 조립방법 | 10-1748252 |
| 28 | 높은 선택비를 갖는 식각방법 및 패턴 형성방법 | 10-1614410 |
| 29 | 플라즈마를 이용한 반도체소자 식각장치 및 반도체 소자 식각방법 | 10-1585945 |
| 30 | 리모트 플라즈마 발생기 및 이를 이용한 반도체 제조장치 | 10-1567696 |

| 명칭 | | 등록 |
|----|------------------------------|------------|
| 31 | 반도체 제조장치 및 이를 이용한 반도체소자 제조방법 | 10-1541392 |
| 32 | 반도체소자의 식각방법 | 10-1251072 |
| 33 | 섀도우마스크를 갖는 플라즈마 도핑장치 및 도핑방법 | 10-1251073 |
| 34 | 균일한 플라즈마 밀도를 위한 플라즈마 소스 및 챔버 | 10-1308687 |
| 35 | 반도체 제조용 챔버의 웨이퍼 고정장치 및 방법 | 10-1157587 |
| 36 | 플라즈마 도핑 장치 및 방법 | 10-1098794 |
| 37 | 반도체소자 제조를 위한 프로세스 챔버의 운영방법 | 10-1075127 |
| 38 | 대구경 웨이퍼 처리 적응형 플라즈마 소스 & 챔버 | 10-1098793 |
| 39 | 적응형 플라즈마 소스를 갖는 플라즈마 반응챔버 | 10-1063319 |
| 40 | 적응형 플라즈마 소스 및 적응형 플라즈마 챔버 | 10-0844027 |

VM 특허 현황_국내

| | 명칭 | 등록 |
|----|----------------------------|------------|
| 41 | 플라즈마 식각방법 | 10-0844029 |
| 42 | 가스 공급 인젝터를 포함하는 플라즈마 공정 장비 | 0748872(20 |
| 43 | 정전척을 포함하는 플라즈마 공정장비 | 0788956(20 |
| 44 | 헬륨 공급부를 포함하는 정전척 장치 | 10-0816526 |

VM 특허 현황_해외

| | 명칭 | 등록 | 등록국가 |
|---|--|---------|------|
| 1 | SPRAYING NOZZLE TYPE OF AN APPARATUS FOR REMOVING A RESIDUAL GAS ON A WAFER | I865270 | 대만 |
| 2 | SUBSTRATE TRANSFER APPARATUS | I888130 | 대만 |
| 3 | SUBSTRATE TRANSFER APPARATUS INCLUDING MULTI-LAYER EFEM | I889064 | 대만 |
| 4 | SUBSTRATE TRANSFER APPARATUS ALLOWING MOVEMENT BETWEEN LAYERS | I889063 | 대만 |
| 5 | SUBSTRATE TRANSFER APPARATUS USING UPPER AND LOWER MAGNETIC LEVITATION RAILS | I863747 | 대만 |
| 6 | 상부 전극의 경사 및 위치 조절 시스템 | 7621002 | 일본 |
| 7 | 셀로우 에칭 프로세스 챔버 | 7607367 | 일본 |
| 8 | SUBSTRATE TRANSFER APPARATUS USING UPPER AND LOWER MAGNETIC LEVITATION RAILS | 7649569 | 일본 |

| | 명칭 | 등록 | 등록국가 |
|----|---|------------------|------|
| 9 | SYSTEM FOR ETCHING WITH A PLASMA | I836422 | 대만 |
| 10 | SYSTEM FOR ETCHING WITH A PLASMA | 7328720 | 일본 |
| 11 | PARTICLE TRAPPING APPARATUS FOR PREVENTING AN ERROR OF A PRESSURE MEASUREMENT | I853228 | 대만 |
| 12 | PARTICLE TRAPPING APPARATUS FOR PREVENTING AN ERROR OF A PRESSURE MEASUREMENT | US 11,841,284 B2 | 미국 |
| 13 | PARTICLE TRAPPING APPARATUS FOR PREVENTING AN ERROR OF A PRESSURE MEASUREMENT | 7450954 | 일본 |
| 14 | An Electrostatic Chuck with Multi Heating Area | I796780 | 대만 |
| 15 | ELECTROSTATIC CHUCK WITH MULTIPLE HEATER ZONES | 7213592 | 일본 |
| 16 | APPARATUS FOR MONITORING AN EXCHANGING PROCESS OF A SEMICONDUCTOR COMPONENT AND A METHOD FOR THE SAME | US 11,538,702 B2 | 미국 |

VM 특허 현황_해외

| | 명칭 | 등록 | 등록국가 |
|----|--|--------------------|------|
| 17 | APPARATUS FOR MONITORING AN EXCHANGING AN ARTICLE OF A SEMI-CONDUCTOR PROCESS AND A METHOD FOR EXCHANGING THE ARTICLE USING THE SAME | 7153362 | 일본 |
| 18 | APPARATUS FOR MONITORING AN EXCHANGING PROCESS OF A SEMICONDUCTOR COMPONENT AND A METHOD FOR THE SAME | 1759960 | 대만 |
| 19 | STRUCTURE VARIABLE TYPE OF A PLASMA SOURCE COIL AND A METHOD FOR CONTROLLING THE SAME | 11315764 | 미국 |
| 20 | STRUCTURE VARIABLE TYPE OF A PLASMA SOURCE COIL AND A METHOD FOR CONTROLLING THE SAME | 6955791 | 일본 |
| 21 | APPARATUS FOR MONITORING AN EXCHANGING PROCESS OF A SEMICONDUCTOR COMPONENT AND A METHOD FOR THE SAME | 6989980 | 일본 |
| 22 | STRUCTURE VARIABLE TYPE OF A PLASMA SOURCE COIL AND A METHOD FOR CONTROLLING THE SAME | CN 1137824 09 B | 중국 |
| 23 | An Apparatus for Arranging an Article of a Semi Conduct Process and a Method for Arranging the Article with the Same | CN 1137824 10 B | 중국 |
| 24 | SEPARATE PLASMA SOURCE COIL AND METHOD OF CONTROLLING THE SAME | CN 1122422 88 B | 중국 |

| | 명칭 | 등록 | 등록국가 |
|----|--|----------|------|
| 25 | SEPARATE PLASMA SOURCE COIL AND METHOD OF CONTROLLING THE SAME | 10825655 | 미국 |
| 26 | SUBSTRATE TRANSFER APPARATUS | 7729643 | 일본 |
| 27 | SUBSTRATE TRANSFER APPARATUS INCLUDING MULTI-LAYER EFEM | 7736325 | 일본 |
| 28 | PLASMA PROCESSING DEVICE INCLUDING BAFFLE FOR PLASMA CONFINING | 7763531 | 일본 |

감사합니다.